



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H5610

对应国外型号
HIT5610

主要用途

作音频放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	750mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-25V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-20V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-1A

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—集电极, C
3—基 极, B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-25			V	$I_C=-10\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-20			V	$I_C=-1\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-10\mu\text{A}$, $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-1	μA	$V_{\text{CB}}=-20\text{V}$, $I_E=0$
H_{FE}	直流电流增益	60		240		$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压		-0.2	-0.5	V	$I_C=0.8\text{A}$, $I_B=-80\text{mA}$
V_{BE}	基极—发射极电压		-0.8	-1	V	$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
f_T	特征频率		360		MHz	$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		38		pF	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$

分档及其标志

A	B	C
60—120	85—170	120—240